



## 新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置: 首页 > 新闻动态 > 综合新闻

### 微电子所参加2011电子封装技术与高密度封装国际会议获好成绩

2011-09-08 | 编辑: 九室 张绪 | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

2011年8月8日—11日,第十二届电子封装技术和高密度封装国际会议(ICEPT-HDP2011)在上海龙东商务酒店举行。中科院微电子所系统封装研究室(九室)派出二十人团队参会并发表论文14篇,受到参会各方面人士的极大关注,其中一篇荣获杰出论文奖(Outstanding Paper Award)。

ICEPT-HDP系列会议多年来得到了电子元件封装和生产技术学会(IEEE-CPMT)的全力支持和IMAPS、ASME和iNEMI等国际著名行业组织的积极参与。ICEPT-HDP 2011由中国电子学会电子制造与封装技术分会(EMPT)主办,上海大学承办,国内外参会代表400余人。与会代表分别围绕先进封装与系统封装、封装材料与工艺、封装设计与模拟、高密度基板及组装技术、封装设备及先进制造技术、质量与可靠性控制、新兴领域封装等8个方面进行了分组讨论。

此次中科院微电子所不仅派出了强大团队参会,论文发表篇数也居各参会单位之首。其中赫然等人的论文《Nonlinear Thermo-Mechanical Analysis of TSV Interposer Filling with Solder, Cu and Cu-Cored Solder》荣获杰出论文奖。该论文提出一种新的TSV的金属填充方法,使用铜芯锡球来快速填充盲孔,具有工艺简单、速度快、成本低的特点,克服了传统填充方法速度慢、成本高的问题。该方法在国际属首创,受到了参会国内外各方的极大关注。另外,王惠娟等人的“高密度三维硅基PN结电容”、张霞等人的“埋入有源元件的功能基板”、周静等人的“高密度高功率芯片封装的散热设计”、赵宁等人的“BT/BST/ST多层薄膜MFM电容”、刘丰满等人的“高密度光电集成测量方法和电学设计”、李君等人的“电子封装的新型散热结构”、郭学平等人的“埋入有源元件的有机基板的热管理”、贾佳等人的“使用GTLE的SiP信号完整性模拟”、王海东等人的“高速互连的串扰分析和优化”、杨坤等人的“引线键合对SiP高速连接的传输特性的影响”、李宝霞等人的“高速封装基板的电源分布网络的超宽带噪声隔离”、陶文君等人的“高速高密度ASIC封装的电学设计”、周云燕等人的“基于GTLE和过孔模型的多层电源分布网络的电源完整性模拟”等研究内容,都吸引了参会者的极大关注。国内外同行对中科院微电子所系统封装技术研究室在电学设计上的优势给予了充分的肯定,并对研究室在光互连领域和三维集成技术的研究表示出极大的兴趣。

此次国际会议对巩固微电子所在封装研究领域的地位,提升在先进封装技术的国际影响力具有积极意义。而参会人员也通过与各方研究人员的交流开拓了视野,看到了与世界先进水平的差距,了解到许多技术信息,为今后科研工作更上一层楼积累了宝贵的经验。

附件下载:



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编: 100029

单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号, 电子邮件: [webadmin@ime.ac.cn](mailto:webadmin@ime.ac.cn)

京公网安备110402500036号